

公司代码：688110

公司简称：东芯股份



**东芯半导体股份有限公司
2025年年度报告摘要**

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-194,793,661.23元，母公司报表2025年度实现净利润-180,275,591.87元。截止2025年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为-136,170,406.50元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-136,170,406.50元，盈余公积43,374,950.95元，资本公积3,587,337,765.29元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积43,374,950.95元和资本公积92,795,455.55元，两项合计136,170,406.50元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

以上公积金弥补亏损方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用**第二节 公司基本情况****1、公司简介****1.1 公司股票简况**适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	东芯股份	688110	不适用

1.2 公司存托凭证简况适用 不适用**1.3 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋雨舟	黄沈幪
联系地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5
电话	021-61369022	021-61369022
传真	021-61369024	021-61369024
电子信箱	contact@dosilicon.com	contact@dosilicon.com

2、报告期公司主要业务简介**2.1 主要业务、主要产品或服务情况****1、主要业务**

公司是目前中国大陆少数能够同时提供 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司，产品广泛应用于网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化、汽车电子等领域。公司致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及服务。公司设计研发的 1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash 均为我国领先的闪存芯片工艺制程，实现了国内闪存芯片的技术突破。



图：公司产品应用示例

2、主要产品及服务

存储芯片通过控制存储单元的电荷状态来实现数据的存储与读取，根据断电后数据是否留存，可分为易失性存储芯片与非易失性存储芯片。公司主要产品涵盖非易失性存储芯片 NAND Flash、NOR Flash，易失性存储芯片 DRAM 及衍生产品 MCP。

(1) NAND Flash

NAND Flash 即数据型闪存芯片，主要分为两大类：一类是大容量 NAND Flash，包括 MLC、TLC 及 3D NAND Flash 等，可擦写次数在数百次至数千次，主要应用于大容量数据存储场景；另一类是小容量 NAND Flash，以 SLC NAND Flash 为主，具备高可靠性，可擦写次数高达到数万级以上。公司 NAND Flash 产品种类丰富，兼具低功耗与高可靠性优势，已通过联发科、瑞芯微、中兴微、博通等主流平台厂商的验证认可，广泛应用于通讯设备（如 5G 模块、光猫）、企业级网关、智能监控、数字录像机、录音笔、词典笔、智能穿戴（手表、手环、AI 眼镜）、汽车电子及机器人等终端产品。

公司聚焦平面型 SLC NAND Flash 的设计与研发，主要产品采用浮栅型工艺结构，制程工艺持续演进至 1xnm 先进水平。产品存储容量覆盖 512Mb 至 32Gb，支持 SPI 或 PPI 类型接口，并可选配 3.3V/1.8V 电压规格，能够灵活满足不同应用领域的差异化需求。在核心技术方面，公司 SPI NAND Flash 采用业内领先的单芯片集成技术，将存储阵列、ECC 模块与接口模块高度集成，有效缩减芯片面积、降低产品成本，并通过合理的冗余管理策略提升了产品可靠性。在功能及性能表现上，公司产品支持更高的时钟频率与 DTR 访问模式，具备高数据吞吐率，深睡眠模式的引入则降低了待机功耗，充分契合移动互联与人工智能领域的新需求。在可靠性方面公司产品表现稳定，单颗芯片可擦写次数超过 10 万次，并能在 $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$ 的极端环境下保持数据有效性长达 10 年，产品可靠性标准已从工业级跨越至车规级。



图：公司 NAND Flash 产品

(2) NOR Flash

NOR Flash 即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及少量数据。其存储阵列采用并联结构，支持按位随机读取与芯片内执行，具备读取速度快、启动时间短等特点，能够满足应用系统对快速启动与及时响应的需求。

公司专注大容量、低功耗 SPI NOR Flash 的设计与研发，采用成熟的 ETOX 工艺架构。产品存储容量覆盖 64Mb 至 2Gb，支持多种数据传输模式，广泛应用于网络通信、可穿戴设备、移动终端、消费电子及汽车电子等领域。在性能与成本控制方面，公司产品时钟频率可高达 166Mhz，支持 DTR 访问模式，配合优化的裸片面积，在数据访问速率、功耗及成本效益上具备了较强的竞争力。此外，ECC、CRC 及高级扇区保护模式，有效提升了数据可靠性与访问安全性。目前，公司 NOR Flash 产品可靠性已全面覆盖工业级与车规级标准。



图：公司 NOR Flash 产品

(3) DRAM

DRAM 是市场主流的易失性存储芯片，利用电容充放电状态实现数据存储。凭借高存取速度与大带宽优势，常作为系统主存、运行内存，用于临时存放运算数据与指令。

公司布局了利基型 DRAM 产品，涵盖标准型与低功耗型两大系列。其中，公司研发的 DDR3(L) 系列支持双倍数据速率传输，具备高带宽、低延时特性，广泛应用于通讯设备、移动终端等领域；针对移动互联网及物联网的低功耗需求，公司自主研发的 LPDDR1/2/4X 系列产品具有低功耗和高传输速度等特点，最高时钟频率可达 2133MHz，适用于智能终端、可穿戴设备等产品。



图：公司 DRAM 产品

(4) MCP

MCP 是将非易失性存储芯片与易失性存储芯片集成于单一封装内的存储解决方案，能够协同实现数据存储与处理功能。

公司的 NAND MCP 产品集成了自主研发的低功耗 1.8V SLC NAND Flash 与低功耗 DRAM，凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科等主流平台通过认证，广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等终端产品。产品规格丰富，DRAM 类型涵盖 LPDDR1、LPDDR2 及 LPDDR4X，为用户提供更加灵活和丰富的选择。MCP 通过集成技术，有效简化了系统走线设计，显著节省 PCB 布板空间，在提升产品稳定性与集成度的同时，降低了整体系统成本，特别适用于对空间要求严苛的小型化电子设备。



图：公司 MCP 产品

(5) 技术服务

公司拥有完全自主知识产权，构建了涵盖芯片设计、版图设计、测试验证、应用分析、工艺整合、质量管控及技术支持的全方位专业团队。依托深厚的技术积累，公司能根据客户特定需求，提供定制化的存储芯片设计服务及整体解决方案，有效协助客户缩短开发周期、降低研发成本、加速产品导入，显著提升开发效率和成功率。

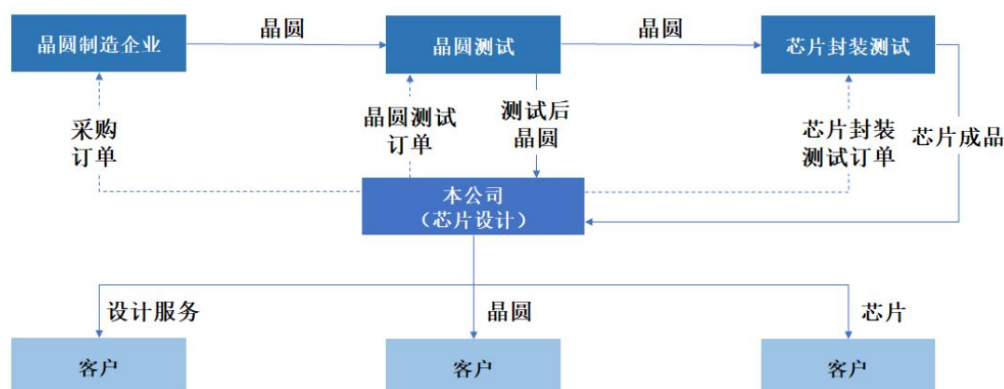
在定制化服务过程中，公司持续深化市场需求洞察与客户反馈收集，建立了“研发-转化-创新”的良性循环机制，推动公司技术实力稳步提升。

2.2 主要经营模式

公司作为 IC 设计企业，采取 Fabless 的经营模式，专注于集成电路设计、销售和客户服务环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。在销售芯片的同时，也根据市场及客户需求提供完整的解决方案。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

公司产品销售采用“经销、直销相结合”的销售模式。经销模式下，公司与经销商之间采用买断式销售；直销模式下，终端客户直接向公司下订单。

公司的整体业务流程如下图所示：



2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专注存储类芯片设计的企业，聚焦中小容量的存储芯片的设计、研发及销售，致力于为客户提供多样化的存储类产品及解决方案。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码：6520)，细分行业为芯片设计行业；根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

根据 WSTS 的 2025 年秋季预测数据，2025 年全球半导体市场规模约为 7,722.43 亿美元，同比增长约 22.5%，其中存储芯片市场规模约为 2,115.68 亿美元，同比增长约 27.8%；预计未来市场将继续呈增长态势，预计 2026 年全球半导体市场规模将进一步增长至约 9,754.60 亿美元，同比增长约 26.3%，2026 年存储芯片市场规模预计达到 2,948.21 亿美元，同比增长约 39.4%。全球半导体行业在经历阶段性调整后，逐步回暖，开启新一轮上行周期，其中存储芯片作为核心增长引擎，受益于人工智能应用、数据中心等需求拉动，增速显著高于行业整体水平。

当前，存储芯片行业正处于由技术创新驱动的结构性的复苏阶段。随着人工智能、云计算等技术的广泛应用，存储芯片市场呈现出需求多元化、应用精细化的基本特点。行业增长动力已从单一的消费电子驱动，转变为由云端算力建设与端侧设备智能化升级共同驱动的新格局。

从需求演变来看，人工智能技术的突破首先带动了数据中心及服务器领域对大容量、高性能存储芯片的强劲需求。随着 AI 应用场景向边缘端延伸，其带动效应已从消费电子领域拓展至工业控制、汽车电子等更广泛的市场。智能手机、可穿戴设备以及各类智能工业终端、新能源汽车电子系统在集成智能化功能的过程中，对存储芯片在特定容量区间内的可靠性、低功耗及环境适应性提出了更高要求。这一趋势有效带动了具备高稳定性与差异化性能的中小容量存储芯片在多领域的渗透与应用，市场需求呈现出从云端数据中心向多元化终端应用扩散的特征。

在具体应用领域方面，下游市场的边界正在不断拓展。网络通讯与安防监控领域受数字化转型及设备迭代影响，对存储芯片的兼容性与供货连续性保持刚性需求。同时，可穿戴设备、智能家居等消费电子市场的创新，也为具备差异化性能的存储产品提供了新的应用空间。智能汽车领域已成为存储芯片的重要增长点，随着智能座舱及高级驾驶辅助系统（ADAS）的渗透率提升，单车存储容量显著增加，且对产品在高复杂环境下的可靠性和稳定性提出了更高标准。

从主要技术门槛来看，存储芯片行业具有技术密集、资金密集的特点。随着应用场景的细化，技术竞争的维度更加多元。在持续推进制程技术演进的同时，产品可靠性与场景适配能力的重要性日益凸显。企业需要攻克高速读写、低功耗设计、高可靠性封装及车规级认证等多项技术壁垒，以满足下游客户对产品在高复杂环境下的稳定性和数据安全性要求，这对企业的研发积累、工艺控制能力及长期供应链管理能力的构成了较高门槛。

综上所述，在人工智能算力建设持续投入以及终端设备智能化浪潮的双重驱动下，存储芯片行业迎来了新一轮的发展机遇。下游应用市场的多元化拓展为行业提供了广阔的增长空间，具备技术积累与市场布局优势的企业有望在这一过程中实现持续发展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是目前中国大陆少数同时具备 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 三大存储芯片自主研发设计能力的企业，在中小容量存储芯片领域建立了全面的产品布局。在 SLC NAND Flash 领域，公司持续推进技术迭代，最先进制程已推进至 1xnm 水平，体现了公司优秀的设计能力和工艺整合技术水平。依托成熟稳定的产品矩阵，公司产品在可靠性、兼容性等方面表现优异，已获得国内外知名企业及下游应用领域头部客户的高度认可，在中小容量存储市场占据了重要的市场地位。在 NOR Flash 与 DRAM 领域，公司坚持差异化竞争策略。NOR Flash 产品制程达到 48nm 行业先进水平，凭借优异的可靠性和宽温工作特性，在对可靠性要求较高的细分市场稳步拓展应用。此外，公司 NAND 产品与 DRAM 产品形成有效协同，结合 MCP（多芯片封装）技术，为客户提供高集成度、小型化的存储解决方案。这种多元化的产品组合有效满足了客户的一站式采购需求，增强了客户粘性，构筑了坚实的竞争壁垒。

面对行业周期性波动与日益激烈的市场竞争，公司积极实行“存、算、联”一体化战略。在稳固存储主业的基础上，公司依托技术积累，积极布局 Wi-Fi 7 等无线通信芯片赛道。这一布局旨在实现业务结构的多元化发展，通过产品线的横向拓展，有效平滑存储行业的周期性业绩波动，同时也为公司面向智能终端与网络设备客户提供更多样化的解决方案创造了有利条件。

未来，公司将继续坚持自主创新的发展道路，紧抓国产替代与下游应用智能化升级的市场机遇。公司将持续推进制程技术迭代，加快车规级与工业级产品的认证与导入，进一步巩固在中小容量存储芯片领域的竞争优势；同时稳步推进“存、算、联”一体化战略，不断提升公司的行业影响力和综合竞争力，致力于成为国内领先的芯片设计与解决方案供应商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) NAND Flash

当前 SLC NAND Flash 主流工艺仍以 2xnm 制程为核心，并持续向更先进节点演进。公司等国内厂商已在 1xnm 工艺节点实现量产突破，推动了国产替代进程的加速。国际大厂如美光、铠侠虽仍主导市场，但国内企业通过持续的工艺优化与成本控制，在消费电子、网络通信等领域的市场份额持续提升。

随着下游应用市场对存储容量与可靠性要求的提升，SLC NAND Flash 凭借高耐久性、低误码率等优势，正加速向网络通信、工业控制、汽车电子等领域渗透。同时，在智能家居、可穿戴设备、医疗电子等新兴市场，其应用边界不断拓展。

从需求端来看，网通设备迭代升级、安防监控智能化、物联网生态扩张等因素持续拉动存储需求；在智能穿戴等细分领域，SLC NAND Flash 在代码存储等场景中凭借更快的擦写速度与更高的存储密度，对 NOR Flash 形成了一定替代，推动了相关细分市场的结构性变化。

从供给端看，行业产能格局持续调整。全球领先的存储器制造商三星已宣布其 MLC 产品进入生命周期终结（EOL）阶段，其他主要厂商如铠侠、SK 海力士及美光的 MLC 产线多以服务既有客户为主，缺乏扩产动力。这一趋势加速了全球 2D NAND 产能的出清，推动行业向 3D NAND 及先进 DRAM 主导的时代迈进。对于国内存储厂商而言，国际大厂的产能战略调整带来了重要的结构性市场机遇，公司有望凭借在先进制程的技术积累与产能布局，进一步扩大市场份额。

(2) NOR Flash

NOR Flash 目前的主流工艺制程为 55nm，广泛应用于智能手机、PC、DVD、TV、USB Key、机顶盒、物联网设备等代码闪存领域，是嵌入式系统代码存储的首选方案。串行接口（SPI）NOR Flash 因设计简洁、成本更低，随着工艺进步已能满足多数系统需求，逐渐成为系统方案商的主流选择，在市场集中度不断提升的背景下，成本优化成为行业共同追求的目标。目前市场上 ETOX 架构应用广泛，部分厂商通过 SONOS、NORD 等差异化技术路径实现成本控制。国内企业凭借高性价比产品持续切入市场，并通过产品容量升级与制程迭代，逐步构建起竞争优势。

展望未来，全球 AI 技术的快速发展为 NOR Flash 市场注入了新的增长动力。AI 时代对 SoC 中的 CPU、NPU、GPU 性能要求提升，推动 NOR Flash 向高带宽、低延迟方向演进，以满足代码存储与快速启动需求。在 AI PC 领域，BIOS 代码量增长驱动 NOR Flash 容量升级；在 AI 眼镜等轻量化场景中，低功耗存储方案获得更多应用，单机 NOR Flash 用量显著提升；TWS 耳机主动降噪、空间音频等功能推动容量的不断提升；物联网终端设备的普及亦为市场提供了稳定的基础需求。公司将顺应市场趋势，持续进行产品迭代，以满足智能化时代对 NOR Flash 存储芯片的新需求。

(3) 利基型 DRAM

利基型 DRAM 是半导体存储市场的重要细分领域，当前以 DDR3、小容量 DDR4 及 LPDDR4X 等产品为主，技术路线聚焦于稳定性和兼容性而非追求极致性能指标。需求侧主要受三大领域支撑：消费电子中的智能电视与机顶盒、工业控制中的安防监控与工控设备、以及汽车电子中的车载信息与基础 ADAS 模块。值得注意的是，当前汽车电子对存储性能的需求尚未进入高速迭代周期，车规级产品更强调在极端温度范围（如 -40℃ 至 125℃）下的稳定性和长期运行的可靠性。

在市场供需格局方面，三星、SK 海力士、美光等国际三大原厂持续将产能向 DDR5、LPDDR5X 及 HBM 等高性能、高附加值存储领域倾斜，这在利基型 DRAM 市场形成了显著的供给缺口，为

中国大陆及中国台湾的供应商创造了战略发展机遇。随着物联网终端设备数量突破百亿级，叠加传统电子设备存储升级需求，利基型 DRAM 市场展现出区别于标准存储市场的强抗周期属性。

从技术发展趋势来看，利基型存储产品开始出现定制化存储方案，通过 3D 堆叠技术将存储单元与主控芯片集成，可缩短信息传递路径，提升数据传输效率，实现近存计算。该方案具有高带宽、高经济效益的优势，无需 PCB 走线，进一步节省面积、降低功耗，适用于低功耗、高带宽及中低容量内存需求的场景，如可穿戴设备、边缘服务器、监控设备、ADAS 及协作机器人等。公司正密切关注相关技术发展趋势，并持续推进产品线丰富与性能优化，以更好地满足客户在多元应用场景中的存储需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减 (%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	3,840,168,442.07	3,530,781,006.35	8.76	3,847,165,529.16	3,847,165,529.16
归属于上市公司股东的净资产	3,483,700,774.19	3,209,317,640.11	8.55	3,504,910,863.13	3,504,910,863.13
营业收入	921,425,290.95	640,953,547.07	43.76	530,588,242.52	530,588,242.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	921,306,730.15	639,341,966.86	44.10	529,088,252.94	529,088,252.94
利润总额	-212,066,231.81	-169,352,962.09	不适用	-351,674,324.69	-351,674,324.69
归属于上市公司股东的净利润	-194,793,661.23	-167,141,889.91	不适用	-306,249,693.71	-306,249,693.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-222,001,699.06	-200,689,631.85	不适用	-327,128,659.61	-326,691,659.75
经营活动产生的现金流量净额	-158,178,470.78	-277,639,837.37	不适用	-301,755,851.65	-301,755,851.65

加权平均净资产收益率(%)	-6.22	-4.99	减少1.23个百分点	-8.20	-8.20
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.38	不适用	-0.69	-0.69
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.38	不适用	-0.69	-0.69
研发投入占营业收入的比例(%)	23.43	33.27	减少9.84个百分点	34.34	34.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	142,253,839.61	200,737,822.59	229,549,859.77	348,883,768.98
归属于上市公司股东的净利润	-59,241,841.00	-51,726,658.83	-35,215,751.77	-48,609,409.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,777,810.47	-60,946,182.27	-39,975,379.52	-55,302,326.80
经营活动产生的现金流量净额	-54,353,654.24	-2,038,825.94	-111,411,617.41	9,625,626.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	47,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,842
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
东方恒信集团有限公司	-10,473,556	136,579,279	30.88	0	无	0	境内非 国有法 人
苏州东芯科创股权投资合伙 企业（有限合伙）	-6,633,746	15,866,254	3.59	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司－嘉 实上证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金	369,921	7,037,464	1.59	0	无	0	其他
王小可	6,300,000	6,300,000	1.42	0	无	0	境内自 然人
赵建平	5,500,000	5,500,000	1.24	0	无	0	境内自 然人
泽丰瑞熙私募证券基金管理 （广东）有限公司－泽丰春 华秋实4号私募证券投资基金	5,460,000	5,460,000	1.23	0	无	0	其他
赵吉	4,300,000	4,300,000	0.97	0	无	0	境内自 然人
财通基金－亨通集团有限公 司－财通基金玉泉1886号单 一资产管理计划	3,623,000	3,623,000	0.82	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,061,044	3,244,943	0.73	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	285,752	2,835,717	0.64	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信集团有限公司的控股子公司。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

存托凭证持有人情况

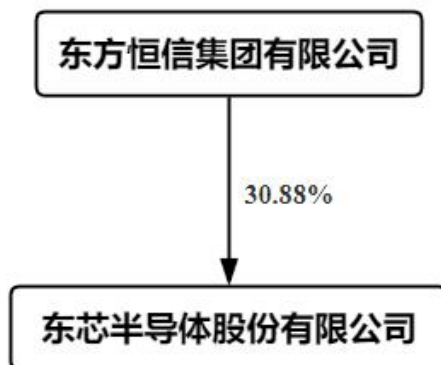
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

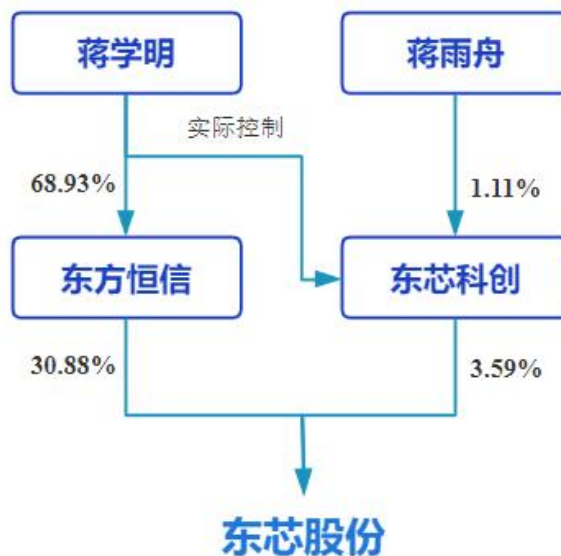
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 92,142.53 万元，较上年同期增长 43.76%；归属于上市公司股东的净利润-19,479.37 万元，同比亏损增加 2,765.18 万元，亏损增加 16.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,200.17 万元，同比亏损增加 2,131.21 万元，亏损增加 10.62%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用